

Реєстраційна картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0105U006929

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-11-2005

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК):

У тому числі по роках:
Загальний обсяг фінансування: 20 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442878922, 0442878922

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут електронної фізики НАНУ

Код за ЄДРПОУ: 05540008

Місцезнаходження: вул.Університетська,21, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88017, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 43650

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СТАНІВ GaAs ПОВІЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ

Назва роботи англійською:

EXCITATION OF GaAs ELECTRON STATES BY SLOW ELECTRONS

Мета роботи українською:

Встановлення закономірностей пружного і непружного зворотного (на 180°) розсіювання моноенергетичних (10-30 меВ) електронів поверхнею арсеніду галія та дослідження його поверхневої й об'ємної електронної енергетичної структури в області енергій 0-5 еВ.

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: В результаті проведених досліджень буде встановлено закономірності пружного і непружного зворотного (на 180°) розсіювання повільних (0-5 еВ) моноенергетичних (10-30 меВ) електронів поверхнею арсеніду галія і виявлено особливості густини розподілу його об'ємних і поверхневих електронних енергетичних станів.

Галузь застосування:

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Фейер Віталій Михайлович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Вивчення процесів збудження електронних станів GaAs(111) повільними електронами та дослідження його електронної енергетичної структури методом спектроскопії зворотного розсіювання електронів низьких енергій.

Початок етапу: 11.2004

Закінчення етапу: 10.2005

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 539.182/.184;535.33/.34, 539.186, 539.188

Коди тематичних рубрик: 29.29.15

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Шпеник Отто Бартоломійович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

Юрченко Т.А.

